

(220) スラグ-溶融金属間反応系における物質移動速度とガス吹込み搅拌条件の関係

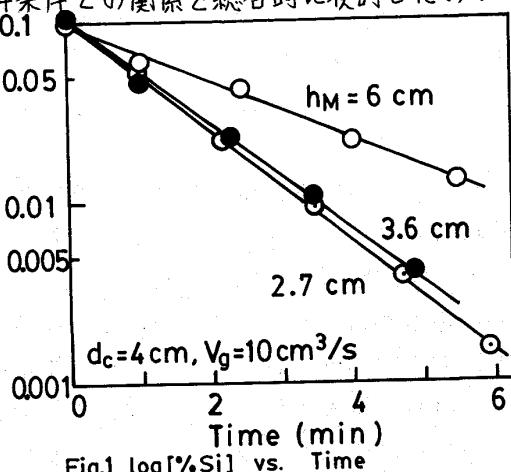
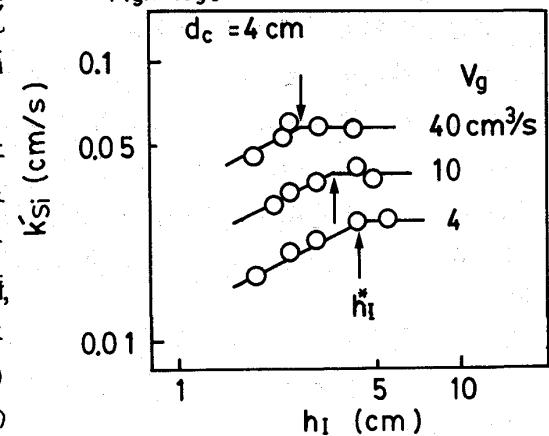
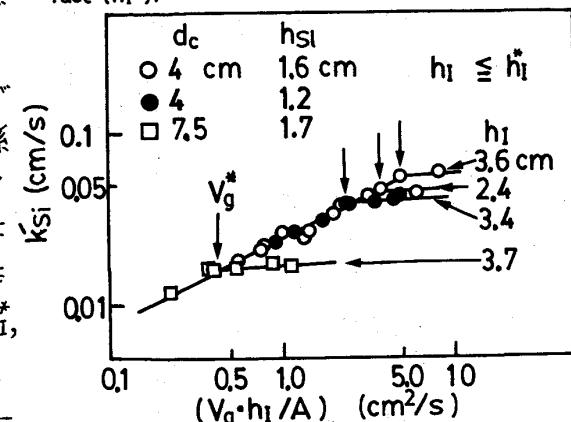
名古屋大学工学部 ○平沢政広 森一美 佐野正道
名古屋大学大学院 岡崎義光 島谷祐司

1. 緒言 当研究室ではスラグ-溶融金属(メタル)間反応速度に及ぼすガス吹込み搅拌の影響を調べるため、溶銅-スラグ系をモデル系とし、メタル側溶質成分の物質移動律速条件下でガス吹込み実験を行っている。今回は特に、物質移動速度に及ぼすメタル深さの影響についての実験を中心として行い、この結果に前報^{1), 2)}までの研究結果を加えて物質移動係数とガス吹込み搅拌条件との関係を総合的に検討したのでその結果について報告する。

2. 実験 SiC 抵抗炉を用い、1250°C, Ar雰囲気下で Al_2O_3 るつぼ中に溶解した Cu-0.1%Si 合金と ($\text{Li}_2\text{O} 28\%$ - $\text{SiO}_2 58\%$ - $\text{Al}_2\text{O}_3 14\%$)-9%FeO の合成スラグ間に(1)の反応をおこさせ、Cu 中 Si濃度の経時変化を調べる。 $\text{Si} + 2\text{FeO} = \text{SiO}_2 + 2\text{Fe}$ (1) 実験中るつぼ底部のノズルから Arガスを吹込みスラグ-メタル浴の搅拌を行う。実験条件は次のようである。①吹込み Ar 流量 $V_g = 25 \sim 540 \text{ Ncm}^3/\text{min}$, ②メタル深さ $h_M = 2.3 \sim 6.5 \text{ cm}$, ③スラグ深さ $h_{sl} = 1.2 \sim 2 \text{ cm}$, ④るつぼ内径 $d_c = 3, 4, 7.5 \text{ cm}$ 。

3. 結果と考察 Fig.1 に実験結果の例を $\log [\% \text{Si}]$ と時間 t の関係として示す。 V_g は 1250°C, 1 atm に換算した値である。搅拌条件によらず $\log [\% \text{Si}] - t$ の直線関係が得られた。実験結果から(2)式に基きメタル側 Si の物質移動係数 k_{Si}' を求める。

$\ln ([\% \text{Si}]_0 / [\% \text{Si}]) = k_{Si}' \cdot (A/V) \cdot t$ (2) ここで、 $[\% \text{Si}]_0$ は Si 初濃度、 A は反応界面積(るつぼ断面積をとる)、 V はメタル体積である。Fig.2 に、 k_{Si}' とノズル先端からスラグ-メタル界面までの距離 h_I との関係を示した。 h_I が小さい時、 $k_{Si}' \propto h_I^{1/2}$ が成立するが、図中矢印で示した h_I^* 以上では k_{Si}' は h_I に依存しなくなる傾向が見られ、一方、 h_I^* は V_g の増大に伴って小さくなる傾向がある。Fig.3 に、前報^{1), 2)} の結果と合わせて k_{Si}' と $(V_g \cdot h_I / A)$ の関係を示した。図は、 $h_I \leq h_I^*$ の範囲で d_c, h_{sl}, h_I, V_g を変化させた場合の結果である。ある範囲では搅拌条件によらず $k_{Si}' \propto (V_g \cdot h_I / A)^{1/2}$ が成立するが、ある V_g^* (図中矢印) から k_{Si}' の V_g 依存性が小さくなることがわかる。また、 V_g^* と搅拌条件との関係を検討した結果、 V_g^* は h_I にはよらず、 d_c, h_{sl} によって変化することがわかった。これらの実験結果は、搅拌によるスラグ-メタル界面近傍の流動状態の変化を反映したものと考えられるところから、この点に関する考察に基づき、 h_I^* 、 V_g^* を含めて実験結果を無次元項を用いて整理する。

Fig.1 $\log [\% \text{Si}]$ vs. TimeFig.2 Apparent mass-transfer coefficient (k_{Si}') vs. Distance between nozzle tip and slag-metal interface (h_I).Fig.3 k_{Si}' vs. $(V_g \cdot h_I / A)$

1) 平沢ら, 鉄と鋼, 71(1985)S131, 2) 平沢ら, 鉄と鋼, 71(1985)S898